SANYO

三洋半導体データシート

No.1075 A
6022

2SC3156

シリコン NPN 三重拡散プレーナ型トランジスタ
スイッチング電源用

◇ 半導体ニューズ No.1075 とさしかえてください。

暫定規格

特長
- 高耐圧である (V_{CBO}≧900V)。
- スイッチングスピードが速い。
- ASO が広い。

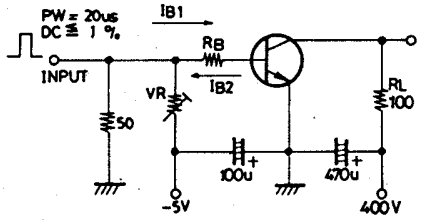
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/T_a=25°C

				unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}		900	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}		800	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}		7	V
コレクタ電流	I_C		6	A
ピークコレクタ電流	i_{cp}	パルス,PW≦300μs, Duty Cycle≦10%	20	A
ベース電流	I_B		3	A
コレクタ損失	P_C	T_c=25°C	120	W
接合部温度	T_j		150	°C
保存周囲温度	T_{stg}		−55～+150	°C

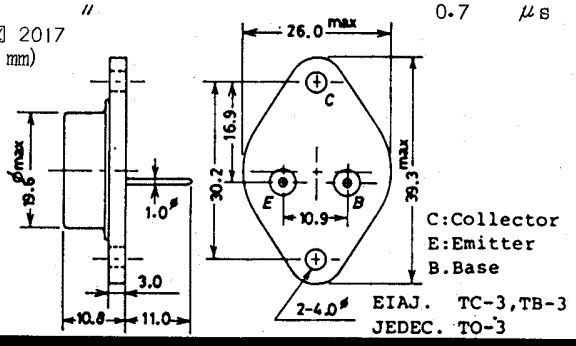
電気的特性 Electrical Characteristics/T_a=25°C

			min	typ	max	unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB}=800V,I_E=0			10	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB}=5V,I_C=0			10	μA
直流電流増幅率	h_{FE}(1)	V_{CE}=5V,I_C=0.4A	10			
	h_{FE}(2)	V_{CE}=5V,I_C=2A	8			
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}=10V,I_C=0.4A		15		MHz
出力容量	c_{ob}	V_{CB}=10V,f=1MHz		120		pF
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=3A,I_B=0.6A			2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	I_C=3A,I_B=0.6A			1.5	V
コレクタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	I_C=1mA,I_E=0	900			V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	I_C=5mA,R_{BE}=∞	800			V
エミッタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=1mA,I_C=0	7			V
コレクタ・エミッタ維持電圧	$V_{CEO(sus)}$	I_C=6A,L=200μH,I_B=2A	800			V
〃	$V_{CEX(sus)}$ (1)	I_C=2A,I_{B1}=0.4A,I_{B2}=0.8A, L=1mH,Clamped	800			V
〃	$V_{CEX(sus)}$ (2)	I_C=1A,I_{B1}=0.2A,I_{B2}=−0.4A, L=2mH,Clamped	900			V
上昇時間	t_{on}	I_C=4A,I_{B1}=0.8A,I_{B2}=−1.6A, R_L=100Ω,V_{CC}=400V			1.0	μs
蓄積時間	t_{stg}	〃 〃			2.5	μs
下降時間	t_f	〃 〃			0.7	μs

スイッチングタイム測定回路



外形図 2017
(unit : mm)



＊これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

〒370-05 群馬県大泉町坂田180 東京三洋電機(株)半導体事業部 TEL 0276-63-2111(大代表)